

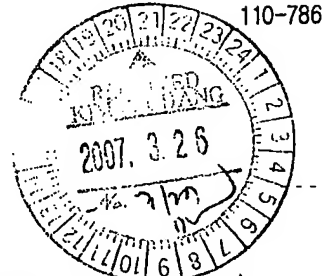
008614

발송번호: 9-5-2007-015479425
발송일자: 2007.03.26
제출기일: 2007.05.26

수신 서울 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명
빌딩 9층(김.장법률사무소)
주성민

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청
의견제출통지서



출 원 인 명 칭 다이킨 고교 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980959164)
주 소 일본국 오사카시 기타구 나카자끼니시 2초메 4반
12고우메다센터빌딩
대 리 인 명 칭 주성민 외 1 명
주 소 서울 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩
9층(김.장법률사무소)
발 명 자 성 명 아라끼, 다카유키
주 소 일본 5668585 오사카후 세쯔시 니시히토쓰야 1반 1고오 다이킨
고교 가부시키가이샤 요도가와 세이사꾸쇼 내
발 명 자 성 명 고, 메이텐
주 소 일본 5668585 오사카후 세쯔시 니시히토쓰야 1반 1고오 다이킨
고교 가부시키가이샤 요도가와 세이사꾸쇼 내
발 명 자 성 명 사또, 가즈유키
주 소 일본 5668585 오사카후 세쯔시 니시히토쓰야 1반 1고오 다이킨
고교 가부시키가이샤 요도가와 세이사꾸쇼 내
발 명 자 성 명 오하시, 미호코
주 소 일본 5668585 오사카후 세쯔시 니시히토쓰야 1반 1고오 다이킨
고교 가부시키가이샤 요도가와 세이사꾸쇼 내
발 명 자 성 명 기사카와, 요스께
주 소 일본 5668585 오사카후 세쯔시 니시히토쓰야 1반 1고오
다이킨고교 가부시키가이샤 요도가와 세이사꾸쇼 내

출 원 번 호 10-2006-7011880
발 명 의 명 칭 레지스트 적층체의 형성 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법 시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[심사결과]

거절이유가 있는 청구항 : 제1항 내지 제18항
청구항외 심사결과 : 상세한 설명에 대한 거절이유
등록가능한 청구항 : 없음

[이유]

<거절이유가 있는 청구항에 대한 이유>

가. 이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제18항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지정한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1. 이 출원의 특허청구범위 제1항은 (I) 기판 상에 포토레지스트층 (L1)을 형성하는 공정, 및 (II) 포토레지스트층 (L1) 상에 친수성기 Y를 갖는 불소 함유 중합체 (A)를 포함하는 코팅 조성물을 도포함으로써 반사 방지층 (L2)를 형성하는 공정을 포함하는 포토레지스트 적층체의 형성 방법으로서, 불소 함유 중합체 (A)가 친수성기 Y를 함유하는 불소 함유 에틸렌성 단량체 유래의 구조 단위를 가지며, 상기 불소 함유 중합체 (A)가, (i) 친수성기 Y가 pKa로 11 이하의 산성 OH기를 포함하는 것, (ii) 불소 함유율이 50 질량% 이상인 것, 및 (iii) 불소 함유 중합체 (A) 100 g 중의 친수성기 Y의 몰수가 0.14 이상인 포토레지스트 적층체의 형성 방법을 특징으로 하고 있으나,

이 출원의 우선일 이전에 반포된 간행물 일본특허공보 특개평11-124531호 (1995.05.11., 이하 ‘인용발명1’이라함)에 코팅조성물에 관한 것으로 식1로 나타내지는 중합단위를 포함하는 불소계 집합체, 또는 식1로 나타내지는 중합단위, 식2로 나타내지는 중합단위를 포함하는 불소계 집합체를 함유하는 코팅조성물이 기재(인용발명1, 특허청구범위 제1항)되어 있고, 포토레지스트를 이용한 포토리소그래피에 의해 패턴을 형성하는 것에 대해 포토레지스트층이 코팅조성물로부터 형성된 반사방지막을 가지는 포토레지스트 패턴형성방법이 기재(인용발명1, 특허청구범위 제3항)되어 있고, 또한 식1로 나타내는 중합 단위 비율이 40 내지 100몰%인 것이 기재(인용발명1, 식별번호[18])되어 있습니다.

양발명을 대비하면, (I) 기판 상에 포토레지스트층 (L1)을 형성하는 공정, 및 (II) 포토레지스트층 (L1) 상에 친수성기 Y를 갖는 불소 함유 중합체 (A)를 포함하는 코팅 조성물을 도포함으로써 반사 방지층 (L2)를 형성하는 공정을 포함하는 포토레지스트 적층체의 형성 방법으로서, 불소 함유 중합체 (A)가 친수성기 Y를 함유하는 불소 함유 에틸렌성 단량체 유래의 구조 단위를 가지며, (ii) 불소 함유율이 50 질량% 이상인 것이 동일하고, 다만 이 출원이 (i) 친수성기 Y가 pKa로 11 이하의 산성 OH기를 포함하는 것이나, 인용발명1은 -COOM이 -COOH, -COONH₄ 인 것에 미차가 있으나, 국제특허공보 WO2003/036390호(2003.05.01., 이하 ‘인용발명2’이라함)는 미세패턴 형성방법에 관한 것으로 기판 또는 기판상의 소정의 층상에 적어도 산발생제, 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체를 포함하는 감광성 조성물을 사용하여 미세 레지스트 패턴을 형성하는 방법이 기재(인용발명2, 특허청구범위제1항)되어 있으며, 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체의 구조단위 M1은 1 내지 99몰%, 구조단위 M2는 1내지 99몰%, 구조단위 A1은 0 내지 98몰%인 것이 기재(인용발명2, 특허청구범위제1항) 되어 있으며, 인용발명2의 상세한 설명에 산반응성 관능기 Y'를 가지며, Y'는 -OH, -COOH인 것이 기재(인용발명2, 31페이지)되어 있어서, 인용발명1의 -COOM이 -COOH,

-COONH₄를 대신하여 인용발명2의 산반응성 관능기 Y¹인 -OH, -COOH를 코팅조성물에 적용하는 것은 당업자라면 통상의 기술적인 범위내에서 용이한 것으로 인정되며 이로 인하여 당연히 예측되는 정도 이상의 효과가 있는 것으로도 인정되지 않으며, 또한 친수성기 Y의 몰수가 0.14이상인 것을 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 산반응성기 Y의 함유율이 5 내지 80몰%인 것이 기재(인용발명2, 32,33페이지)되어 있고, 또한 pKa를 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 관능기를 갖는 불소함유 에틸렌성 단량체로부터 유도되는 구조단위에서 Y의 함유율이 5 내지 80몰%를 가지는 것이 기재(인용발명2, 29,32,33페이지)되어 있어서 이들의 단순 반복시험에 의해 달성할 수 있는 것으로 기술적 특징이 없는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제2항은 제1항에 있어서 친수성기 Y를 한정한 것이나, 제1항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1”에서 기재되어 있고, 또한 친수성기 Y를 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 산반응성 관능기 Y¹를 가지며, Y¹는 -OH, -COOH인 것이 기재(인용발명2, 31페이지)되어 있으며, pKa를 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 관능기를 갖는 불소함유 에틸렌성 단량체로부터 유도되는 구조단위에서 Y의 함유율이 5 내지 80몰%를 가지는 것이 기재(인용발명2, 29,32,33페이지)되어 있어서 이들의 단순 반복시험에 의해 달성할 수 있는 것으로 기술적 특징이 없는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

3. 이 출원의 특허청구범위 제3항은 제1항 또는 제2항에 있어서, 불소함유 중합체(A)의 친수성기 Y의 몰수를 한정한 것이나, 제1항 또는 제2항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1,2”에서 기재되어 있고, 또한 불소함유 중합체(A)의 친수성기 Y의 몰수를 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 산반응성기 Y의 함유율이 5 내지 80몰%인 것이 기재(인용발명2, 32,33페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

4. 이 출원의 특허청구범위 제4항은 제1항 있어서, 불소함유 중합체(A)의 친수성기 Y의 몰수를 한정한 것이나, 제1항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1”에서 기재되어 있고, 또한 불소함유 중합체(A)의 친수성기 Y의 몰수를 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 산반응성기 Y의 함유율이 5 내지 80몰%인 것이 기재(인용발명2, 32,33페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

5. 이 출원의 특허청구범위 제5항, 제6항은 제1항에 있어서 불소함유 중합체(A)의 수평균 분자량을 한정한 것이나, 제1항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1”에서 기재되어 있고, 또한 불소함유 중합체(A)의 수평균 분자량을 한정한 것에 관해서는 인용발명1의 불소계 집합체의 수평균 분자량이 $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^4$ 인 것이 기재(인용발명1, 특허청구범위 제2항)되어 있으며 다만, 이 출원이 인용발명1에 비해 분자량 차이가 있으나

이로 인한 현저한 효과를 확인할 수 없는 바, 상기 항 및 상기항을 구성요소로 하는 제5항, 제6항은 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

6. 이 출원의 특허청구범위 제7항은 제1항, 제2항, 제4항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 불소중합체가 화학식 M-1인 것을 한정한 것이나, 제1항, 제2항, 제4항, 제5항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1 내지 5”에서 기재되어 있고, 불소중합체가 화학식 M-1인 것을 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 불소함유아크릴 유도체로부터 유래되는 구조단위로써 구체적인 화학식이 기재(인용발명2, 11,12페이지)되어 있어서, 이 출원의 a,b,c가 0일 때와 동일한 구조를 가지며, 또한 인용발명2에 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체의 구조단위 M1은 1 내지 99몰%, 구조단위 M2는 1 내지 99몰%, 구조단위 A1은 0 내지 98몰%인 것이 기재(인용발명2, 특허청구범위제1항)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

7. 이 출원의 특허청구범위 제8항은 제7항에 있어서 구조단위 M1이 화학식2로 표시되는 것을 한정한 것이나, 제7항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 6”에서 기재되어 있고, 불소중합체가 화학식 M1이 화학식2로 표시되는 것을 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 구조단위 M1로서 레지스트에 필유한 산반응성 관능기 Y 또는 그 밖의 관능기를 갖는 불소함유 에틸렌성 단량체로부터 유도되는 구조단위를 가지며, 산반응성 관능기 Y를 포함하는 구체적인 화학식이 기재(인용발명2, 13,14페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

8. 이 출원의 특허청구범위 제9항은 제7항에 있어서 구조단위 M1이 화학식3로 표시되는 것을 한정한 것이나, 제7항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 6”에서 기재되어 있고, 불소중합체가 화학식 M1이 화학식3로 표시되는 것을 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 불소함유 중합체로써 현상액에 가용시킬 수 있는 관능기 Y1인 -OH, -COOH기를 갖으며, 구체적인 치환기가 기재(인용발명2, 30,31)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

9. 이 출원의 특허청구범위 제10항은 제1항에 있어서, 불소중합체가 화학식 M-2인 것을 한정한 것이나, 제1항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1”에서 기재되어 있고, 불소중합체가 화학식 M-2인 것을 한정한 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 불소함유아크릴 유도체로부터 유래되는 구조단위로써 구체적인 화학식이 기재(인용발명2, 11,12페이지)되어 있고, 인용발명2에 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체의 구조단위 M1은 1 내지 99몰%, 구조단위 M2는 1 내지 99몰%, 구조단위 A1은 0 내지 98몰%인 것이 기재(인용발명2, 특허청구범위제1항)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

10. 이 출원의 특허청구범위 제11항은, 제1항, 제2항, 제4항 내지 제6항 및 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 코팅조성물에 용제를 더 포함하는 것에 관한 것이나, 제1항, 제2항, 제4항 내지 제6항, 제10항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 1,2,4,5,9”에 기재되어 있고, 용제를 더 포함하는 것에 관해서는 인용발명1의 상세한 설명에 에탄올을 용매로써 사용하는 것이 기재(인용발명1, 식별번호(21))되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

11. 이 출원의 특허청구범위 제12항은 제11항에 있어서 코팅조성물이 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상을 더 포함하는 것에 관한 것이나, 제11항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 10”에 기재되어 있고, 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상을 더 포함하는 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 염기성 물질을 첨가하는 것이 기재(인용발명2, 47,48페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

12. 이 출원의 특허청구범위 제13항은 (A1) 카르복실기를 갖는 불소함유 중합체, (B) 물 및 알코올류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 용제를 포함하는 코팅 조성물로서, 불소 함유 중합체(A)이 화학식 M-3로 표시되고 구조단위 M3를 55 내지 100 몰%, 구조단위 N3을 0 내지 45몰 %포함하며 수평균 분자량이 10000 내지 750000인 불소 함유 중합체인 코팅조성물에 관한 것으로, 인용발명2의 상세한 설명에 구조단위 M1로서 레지스트에 필수한 산반응성 관능기 Y 또는 그 밖의 관능기를 갖는 불소함유 에틸렌성 단량체로부터 유도되는 구조단위를 가지며, 산반응성 관능기 Y를 포함하는 구체적인 화학식이 기재(인용발명2, 13,14페이지)되어 있고, 산반응성 관능기 Y'은 -OH기, -COOH기인 것이 기재(인용발명2, 31페이지)되어 있고, 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체의 구조단위 M1은 1 내지 99몰%, 구조단위 M2는 1내지 99몰%, 구조단위 A1은 0 내지 98몰%인 것이 기재(인용발명2, 특허청구범위제1항)되어 있으며, 또한 인용발명1의 불소계 집합체의 수평균 분자량이 $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^4$ 인 것이 기재(인용발명1, 특허청구범위 제2항)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

13. 이 출원의 특허청구범위 제14항은 제13항에 있어서 불소함유 중합체(A)의 수평균 분자량을 한정하는 것이나, 제13항의 포토레지스트 적층체 형성방법에 관해서는 상기 “거절이유 가의 12”에서 기재되어 있고, 또한 불소함유 중합체(A)의 수평균 분자량을 한정하는 것에 관해서는 인용발명1의 불소계 집합체의 수평균 분자량이 $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^4$ 인 것이 기재(인용발명1, 특허청구범위 제2항)되어 있으며 다만, 이 출원이 인용발명1에 비해 분자량 차이가 있으나 이로 인한 현저한 효과를 확인할 수 없는 바, 상기항 및 상기항을 구성요소로 하는 제14항은 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

14. 이 출원의 특허청구범위 제15항은 제13항 또는 제14항에 있어서 불소함유 중합체의 구

조단위 M3를 한정한 것이나, 제13항의 코팅 조성물에 관해서는 상기 “거절이유 가의 12, 13” 에 기재되어 있고, 불소함유 중합체의 구조단위 M3를 한정한 것에 관해서는 화학식1로 표시되는 불소함유 중합체의 구조단위 M1은 1 내지 99몰%, 구조단위 M2는 1 내지 99몰%, 구조단위 A1은 0 내지 98몰%인 것이 기재(인용발명2, 특허청구범위 제1항)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

15. 이 출원의 특허청구범위 제16항은 제13항 또는 제14항에 있어서, 코팅조성물에 용제를 더 포함하는 것에 관한 것이나, 제13항의 코팅 조성물에 관해서는 상기 “거절이유 가의 12, 13” 에 기재되어 있고, 용제를 더 포함하는 것에 관해서는 인용발명1의 상세한 설명에 에탄올을 용매로써 사용하는 것이 기재(인용발명1, 식별번호(21))되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

16. 이 출원의 특허청구범위 제17항은 제13항 또는 제14항에 있어서 코팅조성물이 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상을 더 포함하는 것에 관한 것이나, 제13항의 코팅 조성물에 관해서는 상기 “거절이유 가의 12, 13” 에 기재되어 있고, 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상을 더 포함하는 것에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 염기성 물질을 첨가하는 것이 기재(인용발명2, 47,48 페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

17. 이 출원의 특허청구범위 제18항은 제17항에 있어서 코팅조성물이 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 (C)가 암모니아 및 히드록실아민류로부터 선택되는 1종이상인 코팅조성물에 관한 것이나, 제17항의 코팅 조성물에 관해서는 상기 “거절이유 가의 16” 에 기재되어 있고, 코팅조성물이 암모니아 및 유기아민류로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 (C)가 암모니아 및 히드록실아민류로부터 선택되는 1종 이상인 코팅조성물에 관해서는 인용발명2의 상세한 설명에 염기성 물질을 첨가하는 것이 기재(인용발명2, 47,48페이지)되어 있는 바, 이 출원전에 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1,2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

나. 이 출원은 특허청구범위 제7항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

이 출원의 특허청구범위 제7항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식M-1으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제8항은 구조단위 M1이 화학식2으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제9항은 불소

함유 중합체(A)가 화학식M-2으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제10항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식M-2으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제13항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식 M-3으로 표시되는 코팅조성물을 청구하고 있으나, 이 출원의 상세한 설명의 합성예1 내지 18 및 실시예1 내지 14에서는 X_3 가 “H 또는 F, CF_3 , CH_3 ” 인 것에 대해서만 기재되어 있고, X_3 가 “Cl” 인 것에 대해 전혀 기술되어 있지 않으며, 이 출원의 합성에 및 실시예에 기재된 치환기가 청구항에 기재된 모든 치환기를 대표하고 있다고 인정되지 않은 바, 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되지 않으며, 또한 특허청구범위 제11항, 제12항은 제10항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항이고, 특허청구범위 제14항 내지 제18항은 제13항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항으로써, 제10항, 제13항의 기재불비사항을 포함하고 있어서 특허받을 수 없습니다.

다. 이 출원은 특허청구범위 제1항 내지 제12항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1. 이 출원의 특허청구범위 제2항의 “및(또는)”이라는 기재는 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항으로 기재되어 있어 그 발명을 특정하기 곤란한 바, 명확하고 간결하게 기재한 것으로 볼 수 없으며, 또한 특허청구범위 제3항, 제7항, 제8항, 제9항, 제11항, 제12항은 제2항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항으로써, 제2항의 기재불비 사항을 포함하고 있어서 특허받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제1항의 “친수성기 Y가 pKa로 11이하”와 특허청구범위 제2항의 “pKa로 11이하”라는 기재는 하한이 불명확한 수치한정으로 그 구성의 범위를 특정할 수 없으며, 또한 특허청구범위 제2항 내지 제12항은 제1항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항으로써, 제1항의 기재불비 사항을 포함하고 있어서 특허받을 수 없습니다.

3. 이 출원의 특허청구범위 제1항의 “불소 함유율이 50 질량% 이상”이라는 기재는 상한이 불명확한 수치한정으로 그 구성의 범위를 특정할 수 없으며, 또한 특허청구범위 제2항 내지 제12항은 제1항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항으로써, 제1항의 기재불비 사항을 포함하고 있어서 특허받을 수 없습니다.

4. 이 출원의 특허청구범위 제1항의 “친수성기 Y의 몰수가 0.14 이상”과 특허청구범위 제3항의 “친수성기 Y의 몰수가 0.21 이상”이라는 기재는 상한이 불명확한 수치한정으로 그 구성의 범위를 특정할 수 없으며, 또한 특허청구범위 제2항 내지 제12항은 제1항의 인용항 또는 실질적으로 인용하는 인용항으로써, 제1항의 기재불비 사항을 포함하고 있어서 특허받을 수 없습니다.

<청구항의 심사결과에 대한 이유>

이 출원은 발명의 상세한 설명의 기재가 아래에 지정한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제3항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

이 출원의 특허청구범위 제7항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식M-1으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제8항은 구조단위 M1이 화학식2으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제9항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식M-2으로 표시되는 포토레지스트 적층체의 형성방법을 청구하고 있고, 특허청구범위 제13항은 불소 함유 중합체(A)가 화학식M-3으로 표시되는 코팅조성물을 청구하고 있으나, 이 출원의 상세한 설명의 합성예1 내지 18 및 실시예1 내지 14에서는 X_3 가 “H 또는 F, CF_3 , CH_3 ”인 것에 대해서만 기재되어 있고, X_3 가 “Cl”인 것에 대해 전혀 기술되어 있지 않으며, 이 출원의 합성예 및 실시예에 기재된 치환기가 청구항에 기재된 모든 치환기를 대표하고 있다고 인정되지 않은 바, 이 출원은 당업자가 용이하게 실시 할 수 있을 정도로 기재되었다고 인정되지 아니하여서 특허법 제42조제3항의 규정에 의거 특허를 받을 수 없습니다.

[첨 부]

첨부 1 일본공개특허공보 평 11-124531호(1999.05.11) 1부.

첨부 2 W02003036390호 1부. 끝.

2007.03.26

특허청

화학생명공학심사본부
정밀화학심사팀

심사관

김광철



심사관

오현식



<< 안내 >>

귀하께서는 특허법제47조제2항의 규정에 의하여 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 심판 청구시의 보정은 상기 요건보다 더 엄격한 기준이 적용됨을 알려드립니다)

※ 다만, 2001년 7월 1일 전에 제출된 특허출원의 경우에는 구 특허법(2001.2.3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제47조제2항의 규정에 의하여 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있습니다.

※ 보정료 납부안내

- 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

- 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

- 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

※ 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터(☎1544-8080)로 문의하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 ☎(담당심사관 김광철)로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 선사로 139(둔산동 920) 정부대전청사 특허청